

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于实施高品质磷化铟单晶片建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2026年4月3日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过《关于实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”。项目计划总投资18,856万元，由云南鑫耀在现有产能基础上扩建产能，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。

二、项目建设的主要内容

- 1、项目名称：高品质磷化铟单晶片建设项目
- 2、实施主体：云南鑫耀半导体材料有限公司
- 3、建设内容：

项目计划由云南鑫耀在现有厂区租赁厂房，对原有产线进行适应性改造，新增主要工艺设备及公辅设施，在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。

- 4、建设地点：

云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号

5、项目建设期：18 个月

6、项目投资规模及资金来源：项目总投资 18,856 万元，其中：固定资产投资 15,250 万元，铺底流动资金 3,606 万元。资金来源为自有资金及金融机构贷款。

7、项目经济效益：经测算，本项目内部收益率为 49.51%，投资回收期为 4.48 年（含建设期）。（风险提示：上述项目的经济效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险）

三、项目实施主体基本情况

名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：包文东

注册资本：48601.064401 万元

成立日期：2013 年 09 月 10 日

营业期限：2013 年 09 月 10 日至无固定期限

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2 楼

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至目前，公司持有云南鑫耀 55.8324% 股权，云南鑫耀为公司控股子公司。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、存在的风险及应对措施

存在的风险：（1）市场风险。一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。上述市场情况变化将对项目盈利能力产生影响。（2）技术风险。如项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，将导致生产能力和利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（3）组织管理风险。由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，

导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。（4）资金风险。资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。

应对措施：一是深入市场调研，加强前期准备与技术开发，严控产品质量，根据市场变化，动态调整产品方向；二是优化内部管理，挖掘潜力，降低成本，提升生产效率和产品质量；三是推进职工培训与人才引进，完善人才引进与留用机制，增强技术与人才储备，依托成熟技术和经验，高薪引进管理与技术人才，加强知识产权保护；四是成立项目领导小组，明确职责分工，有序推进项目实施；五是保障各阶段资金足额及时到位，科学统筹资金使用，严格落实投资控制，确保项目按期推进。

2、本次对外投资的目的和对公司的影响

磷化铟单晶片属于III-V族化合物半导体材料，具有电子迁移率高、抗辐射能力强、导热性好、禁带宽度高和高频光电转换效率优异等诸多优点，主要用于生产激光器、探测器芯片，是应用于数据中心、高速光模块、高功率激光器等领域的关键基础材料。近年来，随着光通信市场需求的快速增长，高速光模块已进入规模化部署阶段，下游厂商对于磷化铟单晶片的需求持续扩大，同时也对尺寸和品质提出了更高要求，公司现有产能已无法满足市场需求。公司拟通过本次项目投资，紧抓产业发展机遇，进一步扩大产能，提高工艺技术水平，加大关键核心技术的研发及成果转化，推动设备优化升级，提升产品质量和生产效率，从而更好地满足持续增长的市场需求。

本项目实施完成后，公司控股子公司云南鑫耀将具备年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。项目的实施是在现有产能基础上扩建，不会影响现有生产线的运行，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目的实施能够满足当前客户需求并紧跟未来下游需求的趋势，对促进公司产业向深加工方向转型升级有积极意义，有利于进一步增强企业的核心竞争力和盈利能力，实现公司化合物半导体材料产业的高质量发展。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2026年4月4日